

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年5月23日(23.05.2024)



(10) 国際公開番号

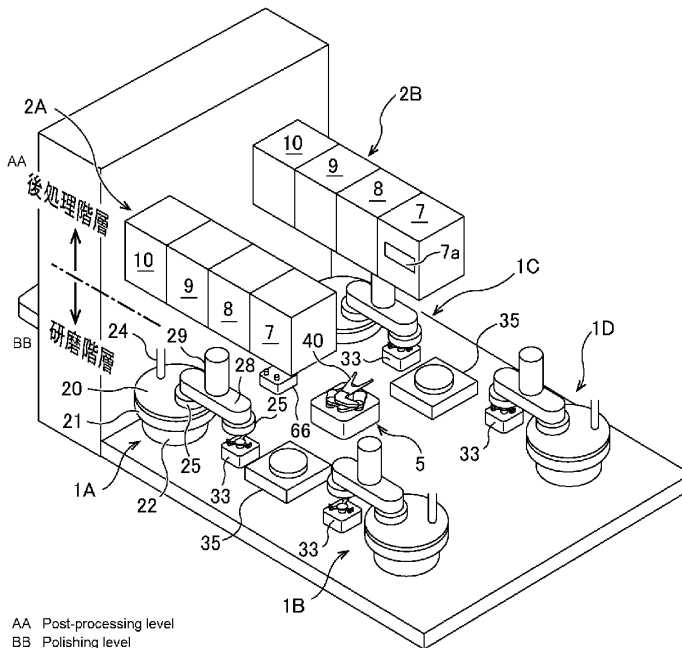
WO 2024/106248 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) B24B 41/06 (2012.01)
B24B 37/10 (2012.01) H01L 21/677 (2006.01)
(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/039880
(22) 国際出願日: 2023年11月6日(06.11.2023)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2022-185102 2022年11月18日(18.11.2022) JP
(71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 宮 ▲ 崎 ▼ 充 (MIYAZAKI, Mitsuru); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 外崎 宏 (SOTOZAKI, Hiroshi); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 武淵 健一 (TAKEBUCHI, Kenichi); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 井上 拓也 (INOUE, Takuya); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). ▲ 高 ▼ 橋 正三 (TAKAHASHI, Shozo); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 石井 亮平 (ISHII, Ryohei);

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: 基板処理装置



(57) Abstract: A substrate processing device comprises: a plurality of polishing modules (1A-1D) that are disposed in a polishing level and that polish a substrate; a post-processing lane (2A, 2B) that is disposed in a post-processing level and that performs post-processing, which includes washing and drying, on the polished substrate; and a lifting/lowering conveyance device (5) that extracts the polished substrate from one of the plurality of polishing modules (1A-1D) and conveys the substrate directly to the post-processing lane (2A, 2B). The post-processing level is an upper level positioned

[続葉有]

〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号
株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (HIROSAWA, Tetsuya et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

above the polishing level or a lower level positioned below the polishing level. The lifting/lowering conveyance device (5) is disposed equidistantly from the plurality of polishing modules (1A-1D). The lifting/lowering conveyance device (5) has a holding hand (40) that enables lifting/lowering between the polishing level and the post-processing level.

(57) 要約: 基板処理装置は、研磨階層内に配置され、基板を研磨する複数の研磨モジュール (1 A ~ 1 D) と、後処理階層内に配置され、研磨された基板に洗浄および乾燥を含む後処理を行う後処理レーン (2 A, 2 B) と、研磨された基板を複数の研磨モジュール (1 A ~ 1 D) のうちの 1 つから取り出し、後処理レーン (2 A, 2 B) に直接搬入する昇降搬送装置 (5) を備える。後処理階層は、研磨階層の上に位置する上層階、または研磨階層の下に位置する下層階である。昇降搬送装置 (5) は、複数の研磨モジュール (1 A ~ 1 D) から同じ距離に配置されており、昇降搬送装置 (5) は、研磨階層と後処理階層との間で昇降可能な保持ハンド (40) を有する。